

2015年5月28日

各 位

レーザーテック株式会社
東証第一部・コード6920
横浜市港北区新横浜2-10-1
代表者名 代表取締役社長 岡林 理
発表担当 第1ソリューションセールス部
リーダー 神山 弦一郎

SiC ウェハ欠陥検査・レビュー装置『SICA』、昭和電工(株)で採用

当社のSiC ウェハ欠陥検査・レビュー装置『SICA』が、SiC エピタキシャルウェハの業界リーダーである昭和電工株式会社（以下、昭和電工）に採用されました。

昭和電工は、SiC エピタキシャルウェハで世界最高水準の均一性と低欠陥性を兼ね備えた大口径品の量産化技術を確立し、その品質と供給体制で定評があります。このたび、同社はさらなる品質強化に向けた取り組みの一環として、当社のSiC ウェハ欠陥検査・レビュー装置『SICA』の採用を決定しました。同社は、2011年にR&D用途で当社の従来機種を導入しており、今回は2台目として、量産対応が可能な高スループットの最新機種を採用します。

次世代パワー半導体の新たな材料として大きな期待と注目を集めているSiC デバイスの本格的な普及に向け、SiC エピタキシャルウェハの高品質化への要望がますます高まっております。その中でも、研磨プロセス、及びエピタキシャルプロセスは、ウェハ品質を決定する最も重要なプロセスとなります。

特に、デバイスの特性に影響がある欠陥については、ウェハ表面のスクラッチやエピ欠陥はもとより、エピ膜内部の基底面転位や積層欠陥にいたるまでを高速に検出・分類し、各種の欠陥を低減することが、ウェハの高品質確保と歩留まり向上の喫緊の課題となってきました。当社は、2009年にSiC ウェハ欠陥検査・レビュー装置の1号機を発売して以来、様々な改良を重ね、多くのお客様に『SICA』を納入してまいりました。これからもフォトルミネッセンスによる新たな高精度・高感度の内部欠陥検査技術などの開発に一層力を注ぎ、これらの欠陥をさらに高速かつ同時検査・分類が可能な装置をご提供してまいります。

以上